

シリコンPNPエピタキシャル形トランジスタ (PCT方式)
SILICON PNP EPITAXIAL TRANSISTOR (PCT PROCESS) (TENTATIVE)

2SA493

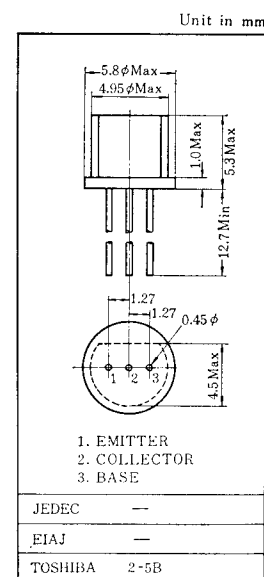
○ 低周波低雑音増幅用

○ Low Noise Audio Amplifier Applications

- 高耐圧です: $V_{CE0} = -50V$
- 低雑音です: $NF = 2dB (Max.)$ ($f = 120Hz$, $R_g = 10 k\Omega$)

最大定格 MAXIMUM RATINGS ($T_a = 25^\circ C$)

Characteristic	Symbol	Rating	Unit
コレクタ・ベース間電圧	V_{CBO}	-50	V
コレクタ・エミッタ間電圧	V_{CEO}	-50	V
エミッタ・ベース間電圧	V_{EBO}	-5	V
コレクタ電流	I_C	-50	mA
エミッタ電流	I_E	50	mA
コレクタ損失	P_C	200	mW
接合温度	T_J	125	$^\circ C$
保存温度	T_{stg}	-55~125	$^\circ C$



電気的特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_a = 25^\circ C$)

Characteristic	Symbol	Condition	Min.	Typ.	Max.	Unit
コレクタシャ断電流	I_{CBO}	$V_{CB} = -30V$, $I_E = 0$	—	—	-100	nA
エミッタシャ断電流	I_{EBO}	$V_{EB} = -5V$, $I_C = 0$	—	—	-100	nA
直流電流増幅率 (Note)	h_{FE}	$V_{CE} = -6V$, $I_C = -2mA$	120	—	400	
雑音指数	NF(1)	$V_{CE} = -6V$, $I_E = 100\mu A$, $f = 10Hz$, $R_g = 10 k\Omega$	—	—	10	dB
	NF(2)	$V_{CE} = -6V$, $I_E = 100\mu A$, $f = 120Hz$, $R_g = 10 k\Omega$	—	—	2	dB

Note ; h_{FE} により下表のように分類し、現品表示してあります。

According to the value of h_{FE} , the 2SA493 is classified as follows.

Classification	Min.	Max.
2SA493—Y	120	240
2SA493—GR	200	400